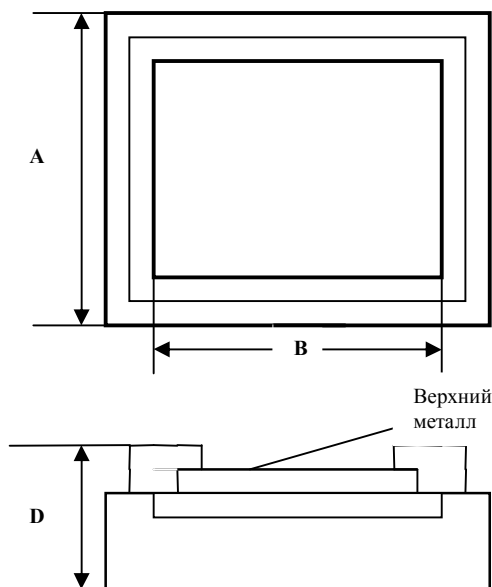


Спецификация на кристалл ультрабыстрого диода 2Д640В -5.

 VSP MIKRON				5A/600V.	
Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма		Темпера- тура пере- хода	
		не менее	не более		
Постоянное обратное напря- жение диода ($I_{обр}=100$ мкА, $\tau_{и}<300$ мкс), В	$U_{обр}$	600	---	$+25\pm 10$ °C	
Постоянное прямое напря- жение ($I_{пр}=5$ А), В	$U_{пр}$	---	1.5	$+25\pm 10$ °C	
Постоянный обратный ток ($U_{обр}=600$ В) ($U_{обр}=480$ В), мкА	$I_{обр}$	---	10	$+25\pm 10$ °C	
			1000	$+125\pm 3$ °C	
Время обратного восстано- вления, ($I_{пр}=1$ А, $di/dt=100$ А/сек, $U_{обр}=30$ В),нс	$t_{вос.обр}$	---	60	$+25\pm 10$ °C	



	Наименование	мкм
A_x A_y	Размер кристалла	2350
B_x B_y	Размер металлизации	1630
D	Толщина	350max.
	Толщина линии скрайбирования	60

Металлизация лицевой стороны : **Al**- Для разварки

Металлизация обратной стороны: **Ti-Ni-Ag** – Для напайки.